

國立交通大學

電子物理學系

博士論文

深層缺陷能階與砷化銦量子點能階之載子交互作用對
於光電容特性影響



**Carriers Interaction between InAs Quantum Dots and a
Deep Defect State on the Photo-capacitance Characteristics**

研究生：楊政鴻

指導教授：陳振芳 博士

中華民國一百零二年七月

Carriers Interaction between InAs Quantum Dots and a Deep Defect State on the Photo-capacitance Characteristics

研究生：楊政鴻

Student : Cheng-Hong Yang

指導教授：陳振芳 博士

Advisor : Dr. Jenn-Fang Chen

國立交通大學

電子物理學系



Submitted to the Institute of Electrophysics

College of Science

National Chiao Tung University

in partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Doctor of philosophy

in

Electrophysics

July 2013

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國一百零二年七月